2000 P23630 WO 10/600351 Dec 15 2003

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

@ 公 關 特 許 公 報 (A) 平3-3310

®Int. Cl. ⁸

識別配号

庁内篮理番号

❷公開 平成3年(1991)1月9日

H 01 G 9/02

3 3 1

7924-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

②特 題 平1-138407

②出 0 平1(1989)5月31日

発明者 金子 敦

女子 東

東京都資梅市東資梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株

式会社内

⑦出 願 人 日本ケミコン株式会社

東京都脅梅市東脅梅1丁目167番地の1

四代 理 人 弁理士 杉林 信益

明 日 日

1. 晃明の名称

固体包容コンデンサの母違方法

- 2. 特許の求の短囲
- (1) 约尼佐金以图化物故园上に、一及式(1)

(式中、 Z は一 C (R *) 中 C H ー . - S ー . 又は ー N (H) ー を 設し、 R *、 R * はそれぞれ 粒立して 水 窓 原子、 又は 低 優 アルコ 中 シ 芸 を 収 す。) で 収 さ れ る く り 返 し 草 位 を 有 す る 固 炊 包 際 質 の ポ リマーの 口 を 有 す る 固 炊 包 際 コンデンサ を 遅 違 す る 方 法 に お い て 、 一 及 式 (I) 、

(式中、Z、及びR'は上記と同じ意味を哀し、Y

は低度アルコキシむ、又は一S・ (R*)(R*)・X **** を寂し、R*及びR*は低度アルキルむを、X はハ ロゲン瓜子を寂す)

で取される切断性ポリマーの溶液を、前便の気化 会以酸化物は風に含収させ、次いでこの含況体を 品処型してこの前層体ポリマーを前配一及式(1) で取されるポリマーに変えた他、ドーパントによ りドーピングすることを特徴とする固体を紹コン デンサのほ迫方法。

- (2) 宮塚佐ポリマーの溶液の溶燃として、ジクロロメタン、トリクロロエタン、クロロホルム、 又はテトラヒドロフランを用いる節求項.1 に記憶の固姓包容コンデンサの国治方法。
- (3) 合松体の急処型を150℃以上で行う約束項1または2に配位の固体ではコンデンサの領定方法。
- 3. 兇明の評和な説明 (点以上の利用分詞)

本兜明は、即吃你会以图化物故以上に、含汲、

熱処理により固体電解質のポリマー膜が形成された固体電解コンデンサの製造方法に関する。

(従来の技術及び発明が解決しようとする課題)

固体電解コンデンサは、アルミニウム、タンタル等の被蔑形成性金属を指状またはブロック状に形成して陽極に用い、その表面に誘電体となる金属酸化被膜層を形成し、次いでその表面に性陰極別を出し手段を設けた排成を有している。従来この固体電解質には、二酸化マンガンが使用されてシガンに変性させていた。

しかしこの方法によれば一度の工程における二 酸化マンガンの付着が僅かであるため同じ処理を 数度ないし十数度繰り返す必要があった。

このため、製造過程が振めて複雑になるとともに、熱分解時の高温や発生するNOIガスの酸化作用などによって、誘電体酸化物被裏を劣化させてしまう欠点があった。

そしてこのように一度多孔質誘電体皮膜が損傷

されると、電解コンデンサはその耐電圧が低下したり、そのもれ電流が増大したり、あるいはその 多孔質誘電体被膜の劣化が進行するなど様々な同

そこで最近では、固体電解質として二酸化マンガンの代わりに導電性ポリマーを使用することが検討されており、例えば導電性高分子として知られているポリ(pーフェニレンビニレン)、ポリ(チェニレンビニレン)、ポリ(ピロリレンビニレン)を固体電解質として用いることも試みられた。

しかしながら、これらのポリマーは安定で不溶 不融性であるため講電体酸化物被膜にキャスティ ングすることが困難であり、固体電解コンデンサ の電解質として使用するには、その性質上無理が あった。

また従来法では低分子量のポリマーをキャスティングするため導電性が劣りドーピング方法にも同 題があった。

(課題を解決するための手段)

本発明はかかる課題を解決するためになされた

ものであり、誘電体金属酸化物被膜上に一般式([)

$$-\frac{R}{2}$$
 CH=CH- (1)

(式中、Zは一C(R*)=CH~.-S~.又は一N(H)-を表し、R'、R*はそれぞれ独立して水素原子、又は低級アルコキシ蓋を表す)

で表されるくり返し単位を有する固体電解質のポ リマーの層を有する固体電解コンデンサを製造す る方法において、一般式(II)

(式中、2、及びR'は上記と同じ意味を表し、Y は低級アルコキシ基、又は一S*(R*)(R*)・X *を表し、R*及びR*は低級アルキル基を、Xは ハロゲン原子を表す)

で表される前駆体ポリマーの溶液を前記誘駆体金 属酸化物液展に合浸させ、ついでこの合浸体を無 処理して、前記前駆体ポリマーを前記一般式(I) すなわち本発明は、前駆体ポリマーが溶媒に溶解して使用することができ、誘電体金属酸化物被膜に容易にかつ高合浸率で含浸させることが可能である点に着目し、含浸体を熱処理後、ドーピング処理すれば、熱安定性、耐久性、電気的特性の優れた固体電解コンデンサが得られることを見出だし、本発明に到途したものである。

本発明で使用される前記一般式(II)で表される 前記ポリマーとしては、例えば次のくり返し単位 を有し、重合度3~1000のものが挙げられる。

特開平3-3310(3)

これらの前図体ポリマーは既知の方法、[polyner preprints, Japan Vol. 38, No. 1(1989)]により段设することができる。

例えば、一級式(日) R.
$$R^{t}$$
 S^{t} $CH_{x_{1}}$ $CH_{x_{2}}$ $CH_{x_{2}}$ R^{t} (日)

(式中、R*,R*,R*,R*及びR*は低級アルキル凸を、 X,及びX。はハロゲン瓜子を収し、R'、2は一

and the second second second second

役は、前駆你ポリマーを有過溶処又は水に溶解して行う。有過溶燃としては、ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水余、テトラヒドロフラン等の現状エーテル等の前脛体ポリマーを解解する低級点有過溶燃であればいずれも使用することができる。合設処別は常圧合役法、設圧合役法のいずれも突鈍することが可能である。

前照依ボリマーの目的ボリマーへの絵処別は、 例えば100~300℃の返底で、好ましくは1 50~250℃の返底に加熱し、放分ないし敗吟 同、例えばめ1吟同行う。且合成の低い前照依ボ リマーを使用した切合、この絵処型により且合成 を高めることができる。またこの絵処型は、理録 ガス、アルゴンガス等の不活性ガス雰囲気中で行 うこともできる。

一及式(I)であらわされる目的ポリマーのドー ヒングは化学的ドーピング、包気化学的ドーピン グのいずれの方法も採用することができる。

例えば、化学的ドーピングのドーパントとして

及式(1)、(I)における R^{\dagger} 、Zと同じΩ味をQす)

食団体ポリマーの観気体金は固化物は同への合

は、日々の含子交客性化合物及びご子供与性化合物、即ち、(I)ヨウ窓、以及及びヨウ化以会でのハロゲン、(I)五ファ化ひ会、五ファ化アンチモン、四ファ化ケイ会、五虹化リン、塩化アルミニウムでの金以ハロゲン化物、(E)酸酸、乙ルオロの金以ハロゲンの酸酸、クロロ酸のアロトン酸、(F)三酸化イオウ、二酸化型酸化,アルオロスルホニルパーオキシドのごとを設化が、アンアノキノジメタン、2.3ージクロルーち、6ージシアノバラベンゾキノン、2.3ージブロムー5.6ージシアノバラベンゾキノン、(M)しi.Na.K等のアルカリ金以管が挙げられる。

一方、収収化学的にドーピングするドーパントとしては、(I)PF。、SbF。、AoF。、Sb Cl。でのVa族元素のハロゲン化物アニオン、B F。でのOa族元素のハロゲン化物アニオン、I (I,*)、Br*Cl*等のハロゲンアニオン、ClO。での沿ハロゲン酸アニオン等の除イオンドーパント、及び(I)Li*、Na*、K* 等のアルカリ

特開平3-3310(4)

金属イオン、4級アンモニウムイオン等の陽イオンドーパント等、更には、pートルエンスルホン酸、ナフタレンー2ースルホン酸等のアリールスルホン酸の塩等を挙げることができるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。またこれらのドーパントは一種類、または2種類以上混合して使用してもよい。

本発明の方法で使用する誘電体酸化物被膜は、AliOiからなる被膜のほかTaiOi、NbiOi、TiOi、ZrOi等が挙げられ、例えばAliOi被膜はアルミニウム層の表面を酸化処理して形成することができる。その酸化方法としては公知の積々の方法を用いることが、例えば電圧了0Vで隔極酸化する方法が挙げられる。この電気的酸化条件はその酸化被膜の厚さをどの程度のものにするか、あるいはその使用するアルミニウム層の材質がどのようなものであるかにより使用電圧、化成時間等の条件を調整することができる。

本発明における講覧体金属酸化物被膜の基礎と なる例えばアルミニウム等の層はアルミニウムの 板、箔等をエッチング処理し多孔質化したものが 好ましい。このエッチング処理もアルミニウム層 をどの程度まで多孔質化するかにより適宜任意の 条件を選んで行うことができる。

(実施例)

以下に実施例にて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

実施例1

あらかじめエッチング処理した厚さ500μ mの高純度アルミニウム板を70Vの電圧で隔離酸化し、表面に酸化アルミニウムの誘電体層を形成した化成板に、 CH(OCH3)-CH2-Oが取りでは、上では変更をもつボリ(チェニレンビニレン)の前駆体ボリマー10重量%とテトラヒドロンドロフラン90重量%とからなる溶液を5分間減延圧と対した。 で生成したボリ(チェニレンビニレン)の放射で生成したボリ(チェニレンビニレン)の放射で生成したボリ(チェニレンビニレン)の放射では、ルチジンテトラフルオーレイトのアセトニトリル溶液中で+2.0

V、VS、SCEで1時間電気化学的ドーピングを行った。溶媒で洗浄し乾燥した後、3mm×3mmサイズに切断し、カーボンペーストと緩ベースドで陰極を取り出して外装樹脂をモールドし、コンデンサを作製した。

will be the first the second of the second o

このコンデンサの電気的特性を第1表、第2表 に示す。

この実施例において、前記の電解ドーピングの 代わりにドーパントとして、ヨウ素、発煙破散、 臭素及び三酸化イオウを用い化学ドーピングを行 い電源度を測定したところ以下の結果を得た。

ドーパント	電導度(S/cm)			
ヨウ素	2 . 3 × 1 0 '			
発煙硫酸	3.5×10'.			
臭 素	2 . 7 × 1 0 ¹			
言動ルイオウ	6.5×10*			

实施例 2

- CH(OCH₃)- CH₂-の繰り返し単位をもつポリ(P-フェニレンピニレン)の前駆体ポ

特開平3-3310(5)

をもつポリ(P-フェニレンピニレン)前駆体ポリマーを使用して間根な処理を行った場合にも同様な処理を行った場合にも同様な結果を得た。

包 1 后

初期包

15	"	7 E	1				
				Сар	Tan 8	ESR	LC
				(# F/en2)	(%)	at	at10¥
						·1000KHz	
						(Ω)	(μA)
突	旭	例	1	7.51	0.66	0.02	0.4
爽	尬	例	2	7.49	0.72	0.025	0.4
比	饺	例		4.14	3.58	0.3	1.0

状のアルミニウムを用い、この 袋面に 固体 包 窓 灯 灯 を 形成 する 和 遠と した が、この 発明 は この 和 遠 の 家子 に 限定される もの で は なく、 包 深 コンデンサ で 多用 されて いる む状の アルミニウム 籍 を 陽 む お よ び 险 哲 郎 に 用 い、 両 包 哲 同 を ガ ラ ス 粒 栽 抵 な ど の 多 孔 質 で 分 違 し て や 回 し た 、 や 回 和 遠 の 家子 を 用 い る こ と も 可 館 で ある 。

(発明の効果)

以上評細に説明した辺り、本発明の方法によれば溶解に容易に溶解することのできる前極体ポリマーを協定体金四酸化物故園に含没させるため、いでは上に直接に被照形成することが困難なな自然を対すて一を本発明では前極体ポリマーをを発明では前極体ポリマーをを発明では前極体ポリマーをを発明では前極があることができる。はいいて発生するのはアルコールであるため、はいいないないで発生、耐久性の優れたで解コンサを得ることができる。

特許出回人 日本ケミコン株式会社代 別 人 弁別士 杉 林 印 蘇

第 2 和

2000時間後

(10V.105℃ 穷命試取)

	*			
	∆ Сар	Tand	ESR	LС
	(%)	(%)	at	at107
			100KH2	
			(Ω)	(μA)
突粒例 1	-2.1	1.74	0.05	0.01
突粒例 2	-2.7 ·	2.03	0.058	0.02
比较例	-10	5.45	0.7	0.5

級中、比较例は従来の二酸化マンガンを包房質とする固体電路コンデンサで真施例1と同じアルミニウム包括板に研験マンガンを含扱し250℃で20分詞焼成したものである。

第1級、第2級からみて本発明の固体を終コンデンサは比较例のものに比べて単位面和当たりの容 段が高く、損失性、等個値列抵抗但及び割れ電流 が低い特性を示し、また鳥安定性及び閉久性に低 れたものであることが判る。

なお、この爽施例によれば、弟子の悶哲部に収